

# Information



SY 715

2/87 (11)

Hersteller: VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht" Stahnsdorf

#### Schnelle Si-Gleichrichterdioden mit hohem Wirkungsgrad

Anwendung:

Gleichrichter in Schaltnetzteilen

Freilaufdioden

Rücklaufdioden in Wechselrichtern

Besondere

Merkmale:

Planar-Epitaxial-Technik

soft recovery

niedrige Durchlaßspannung

vernachlässigbare Schaltverluste

niedrige Durchlaß- und Sperrerholungszeit

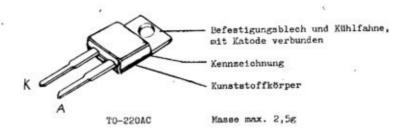


Bild 1: Gehäuse

#### Grenzwerte

10	Kurz-			0	Einheit	Bemerkung
k.	zeichen	min.	typ.	max.	- Lamore	, beiner kung
Periodische						
Spitzensperrspannung	U <sub>RRM</sub>		50		V	SY 715/0,5
yprezensper repaining			100		V	SY 715/1
			150 200		v	SY 715/1,5 SY 715/2
				•.		
Nichtperiodische Spitzensperrspannung	U <sub>RSM</sub>		U RRM		88	
Sperrgleichspannung	UR		URRM			
Betriebsscheitel- sperrspannung	U <sub>RWM</sub>		0,7U <sub>RRM</sub>			empfohlener Wert
Mittlerer Durchlaß-	I <sub>F(AV)</sub>		12,6		Α	Rechteck, 6 = 0,5
strom	, ,		12		Α	Sinus, 180 °el T <sub>C</sub> = 125 °C,
			8.6			f ≥ 50 Hz
Effektiver Durchlaß-	I <sub>F(RMS)</sub>		20		Α	
strom						
Periodischer Spitzendurchlaßstrom	I <sub>FRM</sub>		200		·A	t <sub>p</sub> < 20 /us
StoSstrom	I <sub>FSM</sub>		200		Α	Sinus, 180 <sup>0</sup> eI,
*	1311				200	t <sub>p</sub> = 10 ms
						U <sub>R</sub> = 0 V T <sub>j</sub> = 150 °C
toßstromintegral	1 <sup>2</sup> dt		200		A <sup>2</sup> s	
	•				,,,,,	t <sub>p</sub> = 10 ms, U <sub>R</sub> = 0, T <sub>j</sub> = 150 °C
perrschichttemperatur	T <sub>j</sub>		150		°c	
ehäusetemperatur	T <sub>c</sub>	-55		150	°c	
agerungstemperatur	T <sub>stg</sub>	+5		+35	°c	max. 3 Jahre
		-50	r:	+50	°C	max. 1 Monat
ugkraft an den		0.51111	10		N	einmalig beim Biegen,
Anschlüssen	1					Dauer 10 •

	Kurz- zeichen	min.	typ.	max.	Einheit	Bemerkung
Druckkraft an den Anschlüssen		***	2		N	einmalig beim Montieren
Anzahl der Biegungen der Anschlüsse			1			nur abwinkeln ohne zurückzubiegen Biegewinkel ≤ 90 ° Biegeradiue ≥ 2 mm Abstand vom Kunststoff- körper ≥ 3 mm

Ke	nn	we	r	te
140				

	Kurz- zeichen	min.	typ.	max.	Einheit	Prüfbedingungen
Durchlaßspannung	U <sub>F</sub>			0,85	v	I <sub>F</sub> = 10 A, T <sub>1</sub> = 100 °C - 5 K
				1,30	V	I <sub>F</sub> = 50 A, T <sub>j</sub> = 25 °C - 5 K
Sperrstrom	I <sub>R</sub>			1,30	mA	U <sub>R</sub> = U <sub>RRMmax</sub> , T <sub>j</sub> = 100 °C - 5 K
Sperrerholungszeit	trr	:		35	ns	I <sub>F</sub> = 1 A, -di <sub>F</sub> /dt = 50 A/ <sub>/</sub> us, U <sub>R</sub> = 30 V,
20					.5	I <sub>R</sub> = 0,1 A T <sub>j</sub> = 25 °C - 5 K
Innerer Wärme- widerstand	R <sub>thjc</sub>			2	K/W	
Mittlere Durchlaßverlust- leistung	P <sub>F</sub> (AV)	0,68	V × I <sub>F(AV</sub>	+ 0,023	வ× I <sup>2</sup> F(RMS)	•

### Bestellbezeichnung

Bezeichnung einer Gleichrichterdiode vom Typ SY 710 mit einem Grenzwert der periodischen Spitzensperrspannung von 150 V:

Gleichrichterdiode SY 715/1,5 TGL 43411

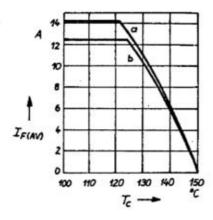


Bild 2: Grenzwert des mittleren Durchlaßstroms in Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur

- a) Rechteck, = 0,5
- b) Sinus, 180 °el

#### Standards

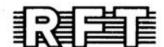
Erzeugnisstandard

TGL 43411

Erzeugnisgruppenstandard

TGL 8097

Anderungen vorbehalten!



## Herausgeber

veb applikationszentrum elektronik berlin im veb kombinat mikroelektronik

Mainzer Straße 25, PF 211

Berlin 1035

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055